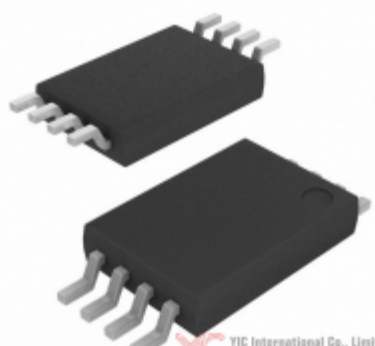


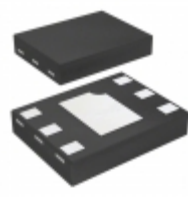





	<b>DMN2016UTS-13</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMN2016UTS-13
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N-CH 20V 8.58A 8-TSSOP
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN2016UTS-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 57469 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	DMN2016UTS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 8.58A 8-TSSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	57469 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	880mW
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.58A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.5 mOhm @ 9.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1495pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)







































DMN2016UTS-13 ist neu im Original, Suche DMN2016UTS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2016UTS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN2016UTS-13: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN2020LSN</b> DIODES DMN2020LSN DIODES</p>	 <p><b>DMN2016LFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 5.2A 8UDFN</p>	 <p><b>DMN2016LHAB-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 6UDFN</p>	 <p><b>DMN2020LSN-7-F</b> DIODES DMN2020LSN-7-F DIODES</p>
 <p><b>DMN2015UFDF-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 15.2A UDFN2020-6</p>	 <p><b>DMN2020LSN-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 6.9A SC59</p>	 <p><b>DMN2017UFDE-7</b> DIODES DMN2017UFDE-7 DIODES</p>	 <p><b>DMN2016UTS</b> D D TSSOP-8</p>

### heiße Teile

Mehr

 DMN2004DWK-7-F	 DMN2004K-7	 DMN2004K-7-F	D DMN2004TK-7	 DMN2004TK-7-F
 DMN2004VK	 DMN2004VK-7	D DMN2004VK-7-G	 DMN2004WK-7	 DMN2004WKQ-7
 DMN2005DLP4K-7	 DMN2005K-7	 DMN2005K-7-F	 DMN2005LP4K-7	 DMN2005LPK-7
D DMN2009LSS	 DMN2009LSS-13	 DMN2009LSS-13-F	 DMN2011UFX-7	 DMN2013UFDE-7
 DMN2013UFDEQ-7	 DMN2015UFDE-7	 DMN2015UFDE.TCT	 DMN2016LFG-7	 DMN2016LHAB-7
 DMN2017UFDE-7	 DMN2019UTS-13	D DMN2020LSN	 DMN2020LSN-7	 DMN2020LSN-7-F
 DMN2020UFCL-7	D DMN2023LSD-13	 DMN2026UVT-7	 DMN2027LK3-13	 DMN2027USS
 DMN2027USS-13	 DMN2027USS-13-F	 DMN2028UFDH-7	 DMN2028USS	 DMN2028USS-13
 DMN2028USS-13-F	 DMN2028UVT-7	 DMN2029USD	D DMN2029USD-13	 DMN2040DTS-13
 DMN2040LSD-13	 DMN2040LSS-13	 DMN2040LTS	 DMN2040LTS-13	 DMN2040LTS-13

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited